

产品概览

NVHL080N120SC1: 碳化硅 MOSFET , N 沟道 , 1200 V , 80 mΩ , TO247-3L

欲看完整文档, 请参阅数据表。



碳化硅 (SiC) MOSFET 使用全新技术, 能够提供卓越的开关性能, 且比硅具有更高的可靠性。另外, 低导通电阻和紧凑的芯片尺寸可确保低电容和低门极电荷。因此, 系统优点有: 最高效率、更快的运行频率、提高了功率密度、降低了 EMI, 以及减小了系统尺寸。

特性

- 1200V rated
- Max RDS(on) = 110mΩ at Vgs = 20V, Id = 20A
- High Speed Switching and Low Capacitance
- 100% UIL Tested
- Qualified for Automotive According to AEC-Q101
- Devices are Pb-Free and are RoHS Compliant

应用

- PFC
- OBC

终端产品

- Automotive DC/DC converter for EV/PHEV
- Automotive On Board Charger
- Automotive Auxiliary Motor Drive

器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	Blocking Voltage BV _{DSS} (V)	I _{D(max)} (A)	R _{DS(on) Typ @ 25°C} (mΩ)	Q _s Total (C)	Output Capacitance (C)	T _J Max (°C)	Package Type
NVHL080N120SC1	5.9999	AEC Qualified PPAP Capable Pb-free Halide free	Active	N-Channel	Single	1200	44	80	56	80	175	TO-247-3LD

欲了解更多信息, 请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn。

创建于: 4/2/2020